



ADVANCED
LINEAR
DEVICES, INC.

ALD1107/ALD1117

QUAD/DUAL P-CHANNEL MATCHED PAIR MOSFET ARRAY

GENERAL DESCRIPTION

The ALD1107/ALD1117 are monolithic quad/dual P-channel enhancement mode matched MOSFET transistor arrays intended for a broad range of precision analog applications. The ALD1107/ALD1117 offer high input impedance and negative current temperature coefficient. The transistor pairs are matched for minimum offset voltage and differential thermal response, and they are designed for precision analog switching and amplifying applications in +2V to +12V systems where low input bias current, low input capacitance and fast switching speed are desired. These MOSFET devices feature very large (almost infinite) current gain in a low frequency, or near DC, operating environment. The ALD1107/ALD1117 are building blocks for differential amplifier input stages, transmission gates, and multiplexer applications, current sources and many precision analog circuits.

FEATURES

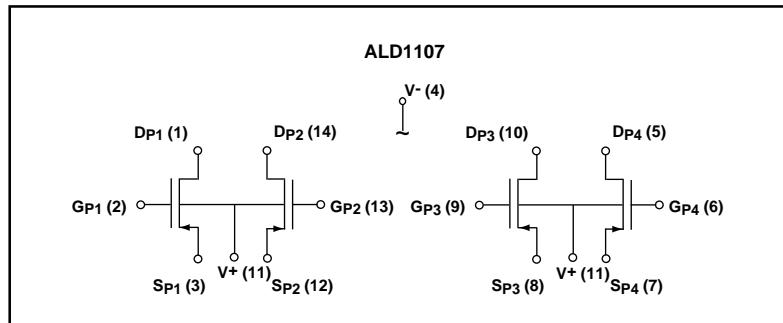
- Low threshold voltage of -0.7V
- Low input capacitance
- Low V_{os} 2mV typical
- High input impedance -- 10¹⁴Ω typical
- Negative current (I_{DS}) temperature coefficient
- Enhancement-mode (normally off)
- DC current gain 10⁹
- Low input and output leakage currents
- RoHS compliant

ORDERING INFORMATION ("L" suffix denotes lead-free (RoHS))

Operating Temperature Range*		
0°C to +70°C	0°C to +70°C	-55°C to +125°C
8-Pin SOIC Package	8-Pin Plastic Dip Package	8-Pin CERDIP Package
ALD1117SAL	ALD1117PAL	ALD1117DA
14-Pin SOIC Package	14-Pin Plastic Dip Package	14-Pin CERDIP Package
ALD1107SBL	ALD1107PBL	ALD1107DB

* Contact factory for leaded (non-RoHS) or high temperature versions.

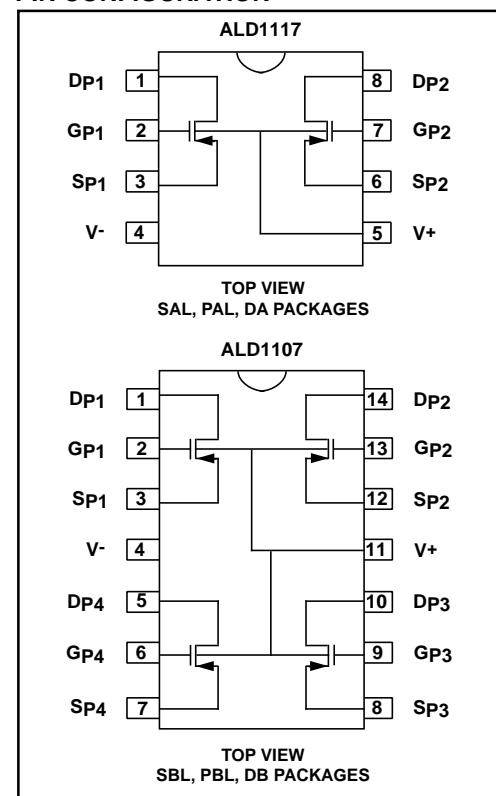
BLOCK DIAGRAM



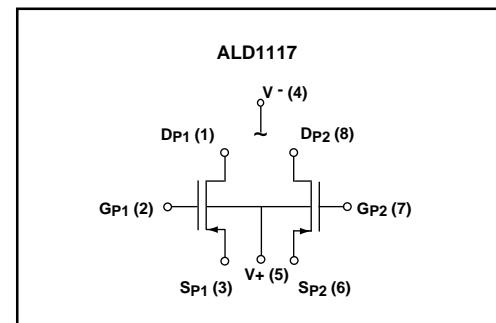
APPLICATIONS

- Precision current mirrors
- Precision current sources
- Voltage choppers
- Differential amplifier input stage
- Voltage comparator
- Data converters
- Sample and Hold
- Analog signal processing

PIN CONFIGURATION



BLOCK DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Drain-source voltage, V_{DS}	-10.6V
Gate-source voltage, V_{GS}	-10.6V
Power dissipation	500mW
Operating temperature range SAL, PAL, SBL, PBL packages	0°C to +70°C
DA, DB packages	-55°C to +125°C
Storage temperature range	-65°C to +150°C
Lead temperature, 10 seconds	+260°C

CAUTION: ESD Sensitive Device. Use static control procedures in ESD controlled environment.

OPERATING ELECTRICAL CHARACTERISTICS

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

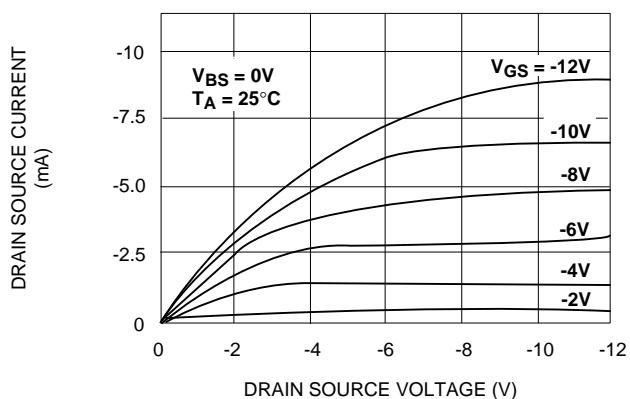
Parameter	Symbol	ALD1107			ALD1117			Unit	Test Conditions
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
Gate Threshold Voltage	V_T	-0.4	-0.7	-1.0	-0.4	-0.7	-1.0	V	$I_{DS} = -1.0\mu\text{A}$ $V_{GS} = V_{DS}$
Offset Voltage $V_{GS1}-V_{GS2}$	V_{OS}		2	10		2	10	mV	$I_{DS} = -10\mu\text{A}$ $V_{GS} = V_{DS}$
Gate Threshold Temperature Drift ²	TC_{VT}		-1.3			-1.3		mV/°C	
On Drain Current	I_{DS} (ON)	-1.3	-2		-1.3	-2		mA	$V_{GS} = V_{DS} = -5\text{V}$
Transconductance	G_{IS}	0.25	0.67		0.25	0.67		mmho	$V_{DS} = -5\text{V}$ $I_{DS} = -10\text{mA}$
Mismatch	ΔG_{fs}		0.5			0.5		%	
Output Conductance	G_{OS}		40			40		μmho	$V_{DS} = -5\text{V}$ $I_{DS} = -10\text{mA}$
Drain Source On Resistance	R_{DS} (ON)		1200	1800		1200	1800	Ω	$V_{DS} = -0.1\text{V}$ $V_{GS} = -5\text{V}$
Drain Source On Resistance Mismatch	ΔR_{DS} (ON)		0.5			0.5		%	$V_{DS} = -0.1\text{V}$ $V_{GS} = -5\text{V}$
Drain Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	-12			-12			V	$I_{DS} = -1.0\mu\text{A}$ $V_{GS} = 0\text{V}$
Off Drain Current ¹	I_{DS} (OFF)		10	400 4		10	400 4	pA nA	$V_{DS} = -12\text{V}$ $V_{GS} = 0\text{V}$ $T_A = 125^\circ\text{C}$
Gate Leakage Current	I_{GSS}		0.1	10 1		0.1	10 1	pA nA	$V_{DS} = 0\text{V}$ $V_{GS} = -12\text{V}$ $T_A = 125^\circ\text{C}$
Input Capacitance ²	C_{ISS}		1	3		1	3	pF	

Notes: ¹ Consists of junction leakage currents

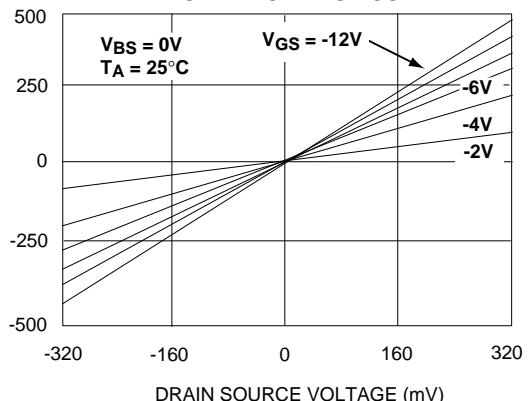
² Sample tested parameters

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

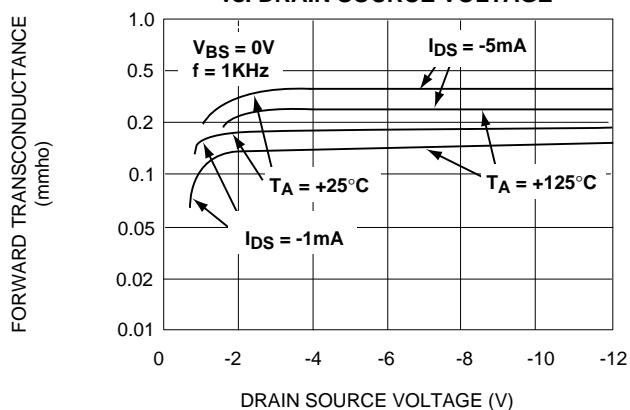
OUTPUT CHARACTERISTICS



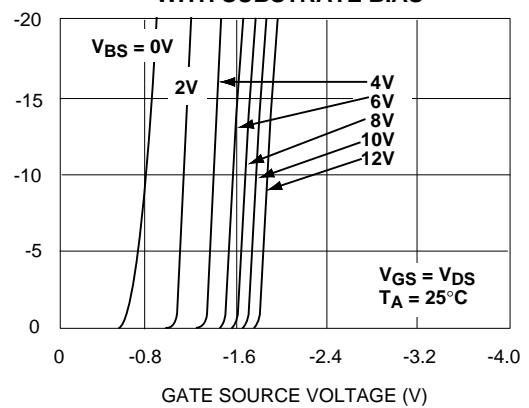
LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS



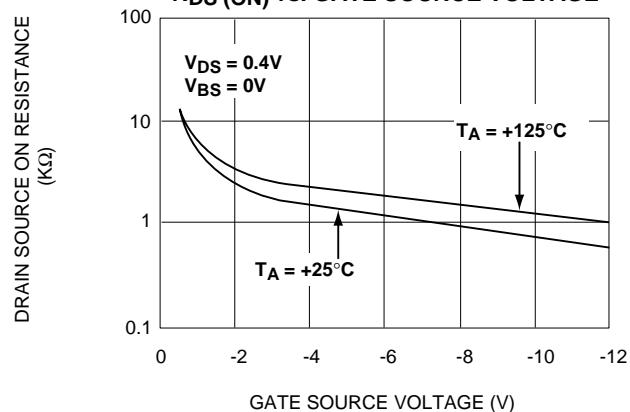
FORWARD TRANSCONDUCTANCE vs. DRAIN SOURCE VOLTAGE



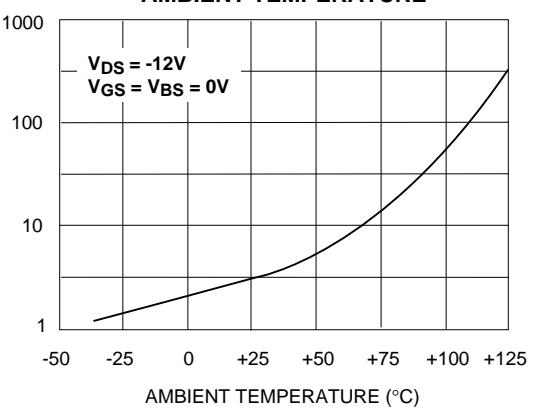
TRANSFER CHARACTERISTIC WITH SUBSTRATE BIAS



DRAIN SOURCE ON RESISTANCE R_DS (ON) vs. GATE SOURCE VOLTAGE

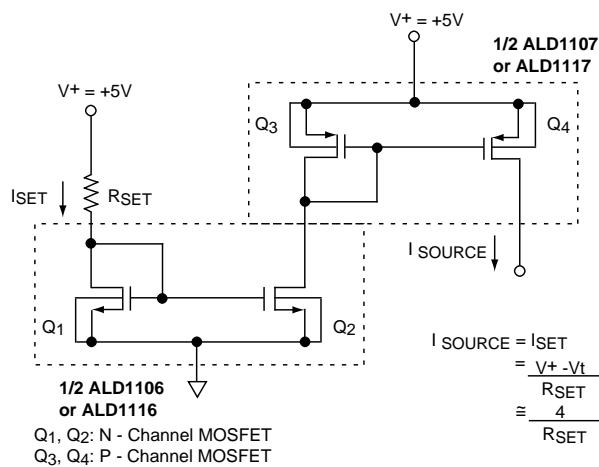


OFF DRAIN CURRENT vs. AMBIENT TEMPERATURE

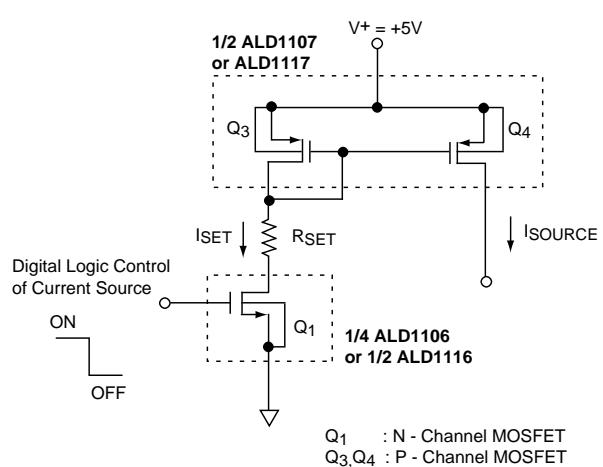


TYPICAL APPLICATIONS

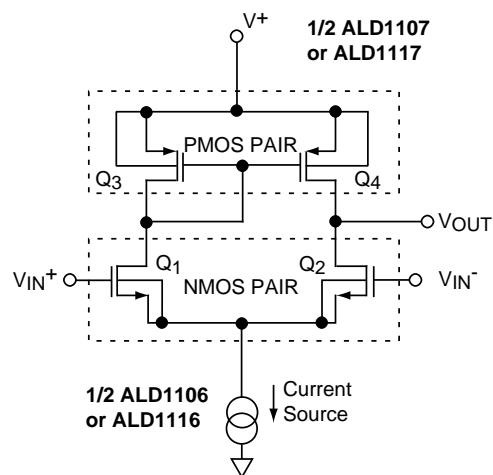
CURRENT SOURCE MIRROR



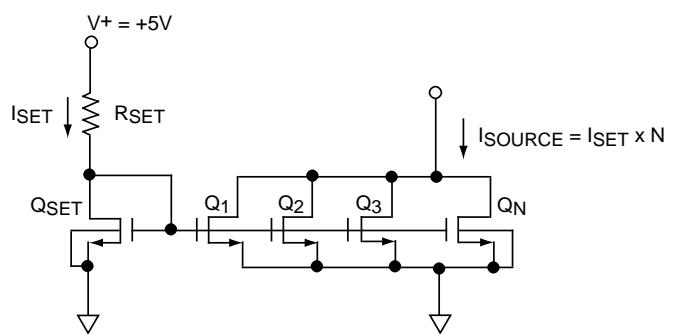
CURRENT SOURCE WITH GATE CONTROL



DIFFERENTIAL AMPLIFIER



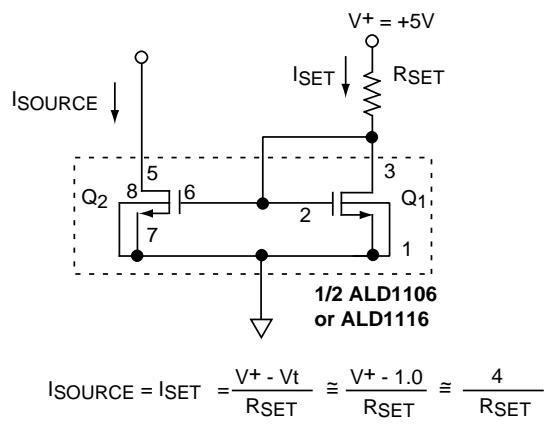
CURRENT SOURCE MULTIPLICATION



TYPICAL APPLICATIONS (cont.)

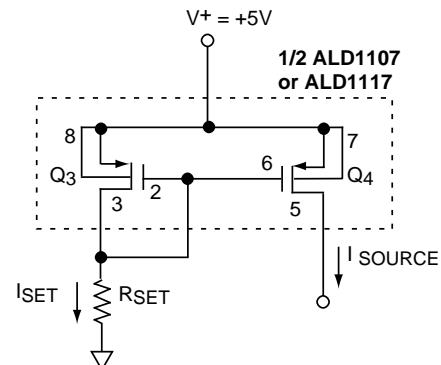
BASIC CURRENT SOURCES

N- CHANNEL CURRENT SOURCE



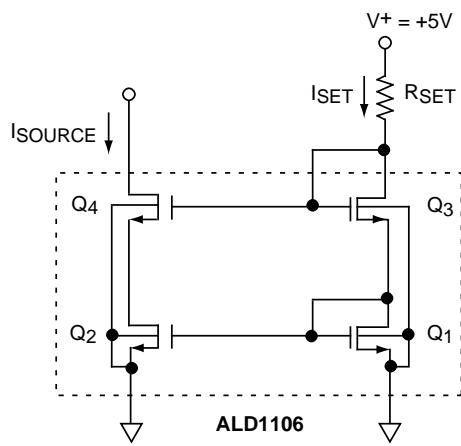
Q₁, Q₂ : N - Channel MOSFET

P- CHANNEL CURRENT SOURCE

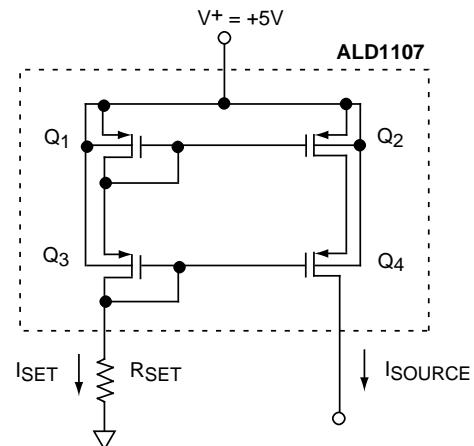


Q₃, Q₄: P - Channel MOSFET

CASCODE CURRENT SOURCES



Q₁, Q₂, Q₃, Q₄: N - Channel MOSFET
(ALD1101 or ALD1103)

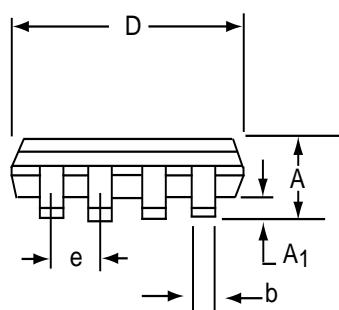
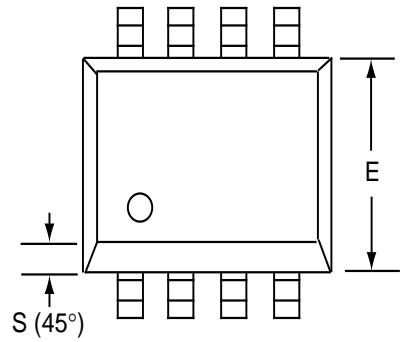


$$I_{SOURCE} = I_{SET} = \frac{V^+ - 2V_t}{R_{SET}} \approx \frac{3}{R_{SET}}$$

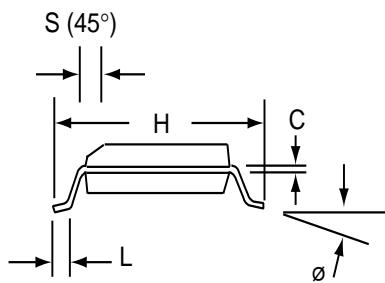
Q₁, Q₂, Q₃, Q₄: P - Channel MOSFET
(ALD1102 or ALD1103)

SOIC-8 PACKAGE DRAWING

8 Pin Plastic SOIC Package

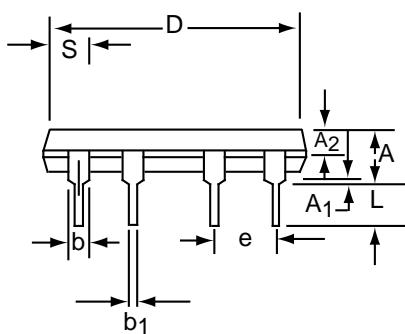
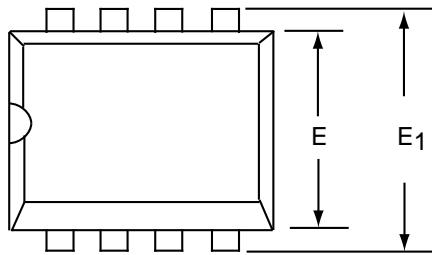


Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A₁	0.10	0.25	0.004	0.010
b	0.35	0.45	0.014	0.018
C	0.18	0.25	0.007	0.010
D-8	4.69	5.00	0.185	0.196
E	3.50	4.05	0.140	0.160
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
H	5.70	6.30	0.224	0.248
L	0.60	0.937	0.024	0.037
Ø	0°	8°	0°	8°
S	0.25	0.50	0.010	0.020

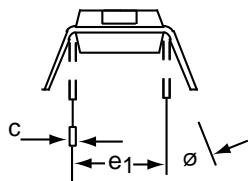


PDIP-8 PACKAGE DRAWING

8 Pin Plastic DIP Package

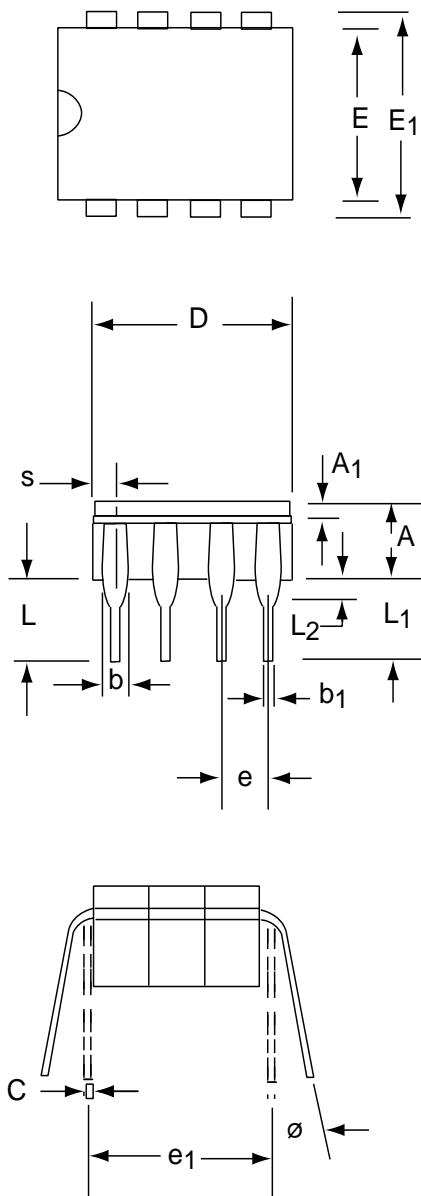


Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.81	5.08	0.105	0.200
A₁	0.38	1.27	0.015	0.050
A₂	1.27	2.03	0.050	0.080
b	0.89	1.65	0.035	0.065
b₁	0.38	0.51	0.015	0.020
c	0.20	0.30	0.008	0.012
D-8	9.40	11.68	0.370	0.460
E	5.59	7.11	0.220	0.280
E₁	7.62	8.26	0.300	0.325
e	2.29	2.79	0.090	0.110
e₁	7.37	7.87	0.290	0.310
L	2.79	3.81	0.110	0.150
S-8	1.02	2.03	0.040	0.080
ø	0°	15°	0°	15°



CERDIP-8 PACKAGE DRAWING

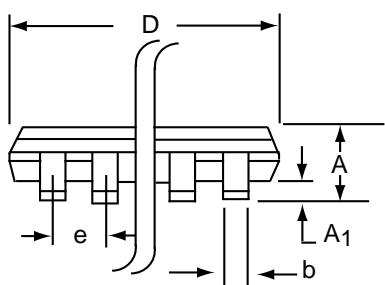
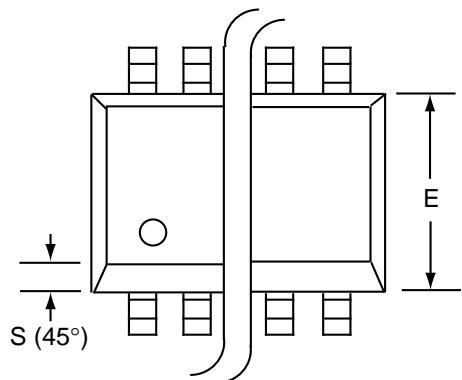
8 Pin CERDIP Package



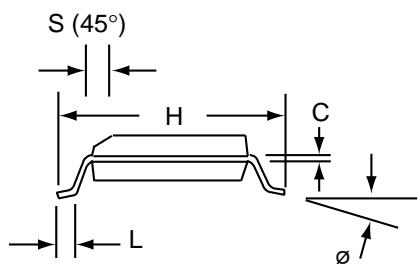
Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.55	5.08	0.140	0.200
A₁	1.27	2.16	0.050	0.085
b	0.97	1.65	0.038	0.065
b₁	0.36	0.58	0.014	0.023
C	0.20	0.38	0.008	0.015
D-8	--	10.29	--	0.405
E	5.59	7.87	0.220	0.310
E₁	7.73	8.26	0.290	0.325
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e₁	7.62 BSC		0.300 BSC	
L	3.81	5.08	0.150	0.200
L₁	3.18	--	0.125	--
L₂	0.38	1.78	0.015	0.070
s	--	2.49	--	0.098
Ø	0°	15°	0°	15°

SOIC-14 PACKAGE DRAWING

14 Pin Plastic SOIC Package

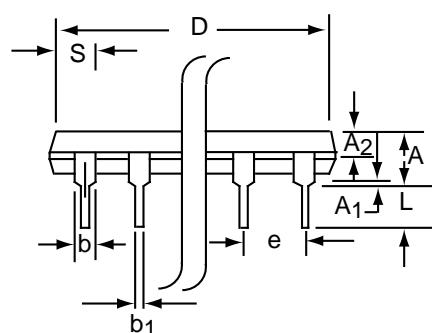
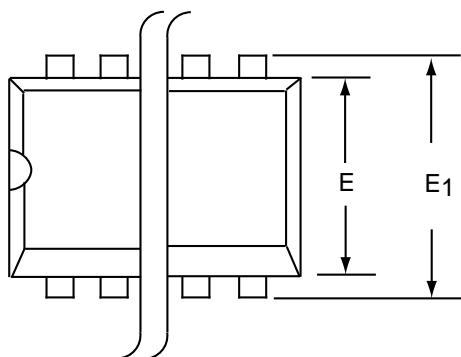


Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.35	1.75	0.053	0.069
A₁	0.10	0.25	0.004	0.010
b	0.35	0.45	0.014	0.018
C	0.18	0.25	0.007	0.010
D-14	8.55	8.75	0.336	0.345
E	3.50	4.05	0.140	0.160
e	1.27 BSC		0.050 BSC	
H	5.70	6.30	0.224	0.248
L	0.60	0.937	0.024	0.037
Ø	0°	8°	0°	8°
S	0.25	0.50	0.010	0.020

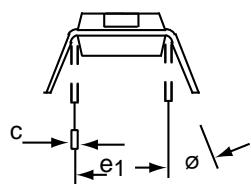


PDIP-14 PACKAGE DRAWING

14 Pin Plastic DIP Package

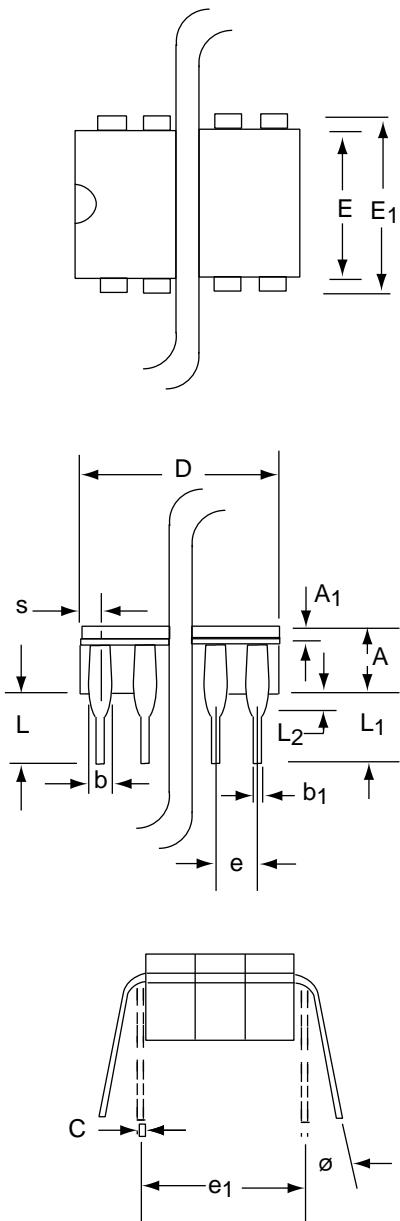


Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.81	5.08	0.105	0.200
A₁	0.38	1.27	0.015	0.050
A₂	1.27	2.03	0.050	0.080
b	0.89	1.65	0.035	0.065
b₁	0.38	0.51	0.015	0.020
c	0.20	0.30	0.008	0.012
D-14	17.27	19.30	0.680	0.760
E	5.59	7.11	0.220	0.280
E₁	7.62	8.26	0.300	0.325
e	2.29	2.79	0.090	0.110
e₁	7.37	7.87	0.290	0.310
L	2.79	3.81	0.110	0.150
S-14	1.02	2.03	0.040	0.080
ø	0°	15°	0°	15°



CERDIP-14 PACKAGE DRAWING

14 Pin CERDIP Package



Dim	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.55	5.08	0.140	0.200
A₁	1.27	2.16	0.050	0.085
b	0.97	1.65	0.038	0.065
b₁	0.36	0.58	0.014	0.023
C	0.20	0.38	0.008	0.015
D-14	--	19.94	--	0.785
E	5.59	7.87	0.220	0.310
E₁	7.73	8.26	0.290	0.325
e	2.54 BSC		0.100 BSC	
e₁	7.62 BSC		0.300 BSC	
L	3.81	5.08	0.150	0.200
L₁	3.18	--	0.125	--
L₂	0.38	1.78	0.015	0.070
s	--	2.49	--	0.098
Ø	0°	15°	0°	15°



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А